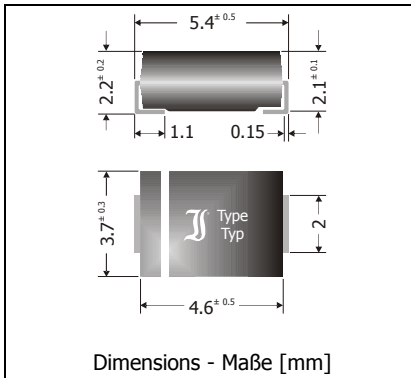


S2D-Q ... S2M-Q

Surface Mount Silicon Rectifier Diodes (AEC-Q101) Silizium-Gleichrichterdioden für die Oberflächenmontage (AEC-Q101)

Version 2014-09-09



Nominal Current – Nennstrom	2 A
Reverse voltage – Sperrspannung	200...1000 V
Plastic case Kunststoffgehäuse	~ SMB ~ DO-214AA
Weight approx. – Gewicht ca.	0.1 g
Plastic material has UL classification 94V-0 Gehäusematerial UL94V-0 klassifiziert	
Standard packaging taped and reeled Standard Lieferform gegurtet auf Rolle	



Maximum ratings and characteristics

Grenz- und Kennwerte

Type Typ	Repetitive peak reverse voltage Periodische Spitzensperrspannung V_{RRM} [V]	Surge peak reverse voltage Stoßspitzensperrspannung V_{RSM} [V]
S2D-Q	200	200
S2G-Q	400	400
S2J-Q	600	600
S2K-Q	800	800
S2M-Q	1000	1000

Max. average forw. rectified current – Dauergrenzstr. in Einwegschaltung	$T_T = 100^\circ\text{C}$	I_{FAV}	2 A ¹⁾
Repetitive peak forward current – Periodischer Spitzenstrom	$f > 15\text{ Hz}$	I_{FRM}	10 A ²⁾
Surge current, 50/60 Hz half sine – Stoßstrom 50/60 Hz Sinus-Halbwellen	$T_A = 25^\circ\text{C}$	I_{FSM}	50/55 A
Rating for fusing, $t < 10\text{ ms}$ – Grenzlastintegral, $t < 10\text{ ms}$	$T_A = 25^\circ\text{C}$	i^2t	12 A ² s
Junction temperature – Sperrschichttemperatur		T_j	-50...+150°C
Storage temperature – Lagerungstemperatur		T_s	-50...+150°C
Forward voltage – Durchlass-Spannung	$T_j = 25^\circ\text{C}$ $I_F = 2\text{ A}$	V_F	< 1.15 V
Leakage current Sperrstrom	$T_j = 25^\circ\text{C}$ $V_R = V_{RRM}$ $T_j = 125^\circ\text{C}$ $V_R = V_{RRM}$	I_R I_R	< 1 µA < 100 µA
Thermal resistance junction to ambient – Wärmewiderstand Sperrschicht-Umgebung		R_{thA}	< 50 K/W ²⁾
Thermal resistance junction-terminal – Wärmewiderstand Sperrschicht-Anschluss		R_{thT}	< 15 K/W

1 R-load – R-Last

2 Mounted on P.C. board with 50 mm² copper pads at each terminal
Montage auf Leiterplatte mit 50 mm² Kupferbelag (Löt-pad) an jedem Anschluss

